n 型有機半導体 BQQDI 誘導体の単結晶構造と電子輸送特性

Single-crystal structure and electron-transport properties of n-type organic

semiconductors BQQDI derivatives

東大院工¹,東大院新領域²,筑波大数理³,北里大理⁴,JST CREST^{5 O}荒井 勇太郎¹,熊谷 翔 平², Craig P. Yu²,石井 宏幸³,渡辺 豪⁴,竹谷 純一^{1,2},岡本 敏宏^{1,2,5}

School of Eng., Univ. of Tokyo¹, GSFS, Univ. of Tokyo², Univ. of Tsukuba.³, Kitasato Univ.⁴,

JST-CREST⁵. ^OYutaro Arai¹, Shohei Kumagai², Craig P. Yu², Hiroyuki Ishii³, Go Watanabe⁴,

Jun Takeya^{1,2}, Toshihiro Okamoto^{1,2,5}

E-mail: y-a-8n@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

n型有機半導体は有機電界効果トランジスタ (organic field-effect transistor, OFET) を用いた相補 型集積回路の高集積化・低消費電力化を実現するために必要不可欠な材料である。しかしながら, n型有機半導体の開発は p型有機半導体よりも遅れており,p型有機半導体と同等の電子移動度 (µ)を示す n型有機半導体を実現するためには,構造-物性相関への理解と分子設計の洗練がよ り一層求められる。

最近当研究室が報告した n 型有機半導体 benzo[*de*]isoquinolino[1,8*gh*]quinolinetetracarboxylic diimide (BQQDI, Fig. 1) 誘導体は, BQQ 骨 格内に位置選択的に導入された窒素により隣接分子間で相互作用 し,結晶中でブリックワーク構造 (Fig. 2) を形成する。その結果, 二次元的な電子輸送パスを形成し,高い μ が観測されている^[1]。ブ リックワーク構造内では,側鎖に応じて分子間の電子軌道の重なり (トランスファー積分, *t*) が変化するため, μ に影響する。したがっ て,側鎖と*t*, μ の関係を調べることで,高移動度 n 型有機半導体の 開発に対する知見が得られることが期待される。



Fig. 1 Chemical structures of BQQDI derivatives

代表的な化合物である PhC₂-BQQDI^[1](Fig. 1) を含む多くの BQQDI 誘導体の結晶構造において, 隣接分子間の C-H…O, C-H…N 相互作用が観測されている (Fig. 2)。一方でシクロヘキシル側鎖 を導入した Cy₆-BQQDI では,明確な C-H…O, C-H…N 相互作用が見られなかった。これは嵩高 いシクロヘキシル基が存在することによるものと考えられる^[2]。シクロヘキシル環上をメチル置 換した MeCy₆-BQQDI についても, Cy₆-BQQDI と同様であった。PhC₂-BQQDI はやや一方向に偏 った t を示す一方で, Cy₆-BQQDI と MeCy₆-BQQDI では等方的な t となった (Fig. 2)。PhC₂-BQQDI

は μ が3 cm²/Vs であるのに対し, MeCy₆-BQQDIは 4 cm²/Vs を示し,等方的なtが高移動度の発現に有 用であることが支持された^[3]。また, Cy₆-BQQDIと MeCy₆-BQQDIの結晶構造では BQQ 骨格の配向に 静的ディスオーダーが観測された。静的ディスオー ダーの無い PhC₂-BQQDIと μ の温度依存性を比較 することで,単結晶中の静的ディスオーダーに由来 するキャリア散乱の影響が示唆された。

[1] T. Okamoto *et al. Sci. Adv.* **6**, eaaz0632 (2020).

- [2] C.P. Yu et al. under review.
- [3] S.Fratini et al. Nat. Mater. 16, 998-1002 (2017).



Fig. 2 (a) Illustration of brick-work structure.(b) Intermolecular interactions in typicalBQQDI derivatives. (c) Calculated transferintegrals of BQQDI derivatives.